**ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ**

**Национального исследовательского университета**

**«Московский институт электронной техники»**

1) Кондрашов В.А., Неволин В.К., Бобринецкий И.И и др. Прогнозирование стабильности и электронных свойств углеродных наноторов, синтезируемых при высоковольтном импульсном разряде в парах этанола // Физика и техника полупроводников. – 2016. – Т. 50. – С. 509–514.

2) Левин Д.Д., Бобринецкий И.И., Емельянов А.В. Особенности функционализации поверхности однослойного и мультислойного графена при окислении под действием ультрафиолетового облучения // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2015. – Т. 20. – С. 259–267.

3) Bobrinetskiy I.I., Otero N., Romero P.M Patterned Graphene Ablation and Two–Photon Functionalization by Picosecond Laser Pulses in Ambient Conditions // Applied Physics Letters. – 2015. – Vol. 107. – P. 043104.

4) Bobrinetskii I.I., Komarov I.A., Lavrent’ev K.K. et al. Features of the Integration of Graphenes in Microelectronic Technology // Russian Microelectronics. – 2014. – Vol. 43. – P. 477–482.

5) Бобринецкий И.И., Комаров И.А., Лаврентьев К.К. и др. Особенности интеграции графенов в технологические процессы микроэлектроники // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2013. – № 3 (101). – С. 33–42.

6) Кондрашов В.А., Неволин В.К., Розанов Р.Ю. Наноразмерные мемристорные структуры на основе хлорида меди с подслоем графена // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2015. – № 1 (35). – С. 60–63.

7) Gorshkov K.V., Nevolin V.K., Chaplygin Yu.A. et al. Investigation of Electrical Properties of Organic Memristors Based on Thin Polyaniline–Graphene Films // Russian Microelectronics. – 2013. – Vol. 42. – P. 27–32.